

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0211U004300

Державний реєстраційний номер: 0109U001143

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-02-2011

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технології оптично-активних структур оптоелектроніки на основі неорганічних, органічних напівпровідників та рідкокристалічних матеріалів з нанорозмірними домішками

Початок етапу: 01.2009

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (032) 237 50 89

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027627

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 104.352
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технології оптично-активних структур оптоелектроніки на основі неорганічних, органічних напівпровідників та рідкокристалічних матеріалів з нанорозмірними домішками

Назва роботи англійською:

Design of technology of optical-active structures for optoelectronics based on inorganic, organic semiconductor and liquid crystal materials with nanosize dopands

Реферат українською:

Розроблено технологічний процес формування інтеркальованих нітридо-галієвих структур на підкладці GaSe методом іонного розпилення Ga в аміачній атмосфері у схрещених електричному і магнітному полях. Визначені технологічні умови створення рідкокристалічних середовищ із нанорозмірними включеннями. Проведена модифікація параметрів напівпровідникових структур методом інтеркаляції рідкого кристала в шаруваті напівпровідники для розробки пристроїв запам'ятовування інформації.

Реферат англійською:

It was developed the technological process of the formation the intercalated gallium nitride based on GaSe surface by means of ion sputtering of Ga in ammonia medium in crossed electric and magnetic fields. It was determined technological conditions of formation a liquid crystalline media with nanoscale dopant . It was realized the parameter modification of semiconductor structures by intercalation of liquid crystal in layered semiconductor for the development of memory devices.

Індекс УДК: 621.396.96.002, 621.38.049.77.002

Коди тематичних рубрик: 47.13.12

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Готра Зенон Юрійович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Технологія оптично-активних структур для пристроїв запам'ятовування та відображення інформації

Назва НТП англійською: The technology optically-active structures for memory devices and display information devices

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування:

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Технологія формування інтеркальованих нітридо-галієвих структур на підкладці GaSe на основі методу іонного розпилення Ga в аміачній атмосфері у схрещених електричному і магнітному полях для пристроїв запам'ятовування інформації. Отримані технологічні умови створення з заданими параметрами рідкокристалічні оптично-активні структури з нанорозмірними включеннями для пристроїв відображення інформації. Реалізована методика модифікації параметрів напівпровідникових структур методом інтеркаляції рідкого кристала в шаруваті напівпровідники.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 3 роки

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Підприємства електронної промисловості НВО "Гелій" (м. Вінниця), Інститут "Мікроприлад" НАН України (м.Київ).

Перспективні ринки: Україна, СНД

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 600

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 400

Очікуваний термін окупності (років): 5

Додаткова інформація: За договорами

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Піх Зорян Григорович

Д. Х. Н.

Перелік осіб-виконавців

Возняк Л.Ю.

Волинюк Д.Ю.

Готра Зенон Юрійович

Касянова Т.А.

Комарницький Ю.

Костів Н.В.

Коцун В.І.

Левенець В.В.

Микитюк З.М.

Петрашак В.

Стахіра П.Й.

Фечан А.В.

Цуканова Л.М.

Черпак В.В.

Шимчишин М.І.

Ясиновська О.Й.

Відповідальний за підготовку

облікових документів

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

